

مدل سازی و تحلیل عددی مبدل‌های تایریستوری به روش رانگ-کوتای چند متغیره

آتیلا اسکندرنژاد^{۱*}، عبدالرضا رحمتی^۲ و سید ادیب ابریشمی فر^۳

اطلاعات مقاله	چکیده
واژگان کلیدی: مبدل تایریستوری، منحنی مشخصه دوران یافته، بلوک دیاگرام، عملگر تفاضلی، روش رانگ-کوتا.	<p>مدل سازی کلیدهای نیمه هادی در مبدل‌های سوئیچینگ از موضوع‌هایی می‌باشد که امروزه، بیشتر مورد توجه مهندسین طراح قرار گرفته است. زیرا به دیدگاه آن‌ها در انتخاب ساختار، مقایسه، تعیین مقادیر اجزای مبدل، حلقه کنترلی و پایداری اشراف بیشتری می‌بخشد. در این مقاله، روشی عددی برای تعیین منحنی ولتاژ و جریان تایریستور در مبدل‌های الکترونیک قدرت ارائه شده است. عناصر موجود در این مبدل‌ها را می‌توان از نظر منحنی مشخصه، به دو گروه خطی و غیرخطی تقسیم‌بندی کرد. در روش پیشنهادی ابتدا منحنی مشخصه دوران یافته سوئیچ را در نظر گرفته و سپس دیاگرامی که گویای ارتباط جریان ولتاژی تریستور است استخراج می‌شود. در ادامه، بلوک دیاگرام منتجه در مدار مبدل جاگذاری می‌گردد. از سوی دیگر ماتریس‌های امدادانس و انتقال مربوط به عناصر خطی به روش نظریه مش و گره تعیین می‌شوند. سپس بلوک دیاگرام سیستمی مبدل که شامل عملگرهای تفاضلی است تعیین شده و با اعمال روش رانگ-کوتای چند متغیره بر بلوک نهایی، مقادیر لحظه‌ای پارامترهای مبدل محاسبه می‌گردد. در انتها نتایج شبیه‌سازی با روش تحلیلی جبری پیشنهادی، مقایسه می‌شود که گویای کارآمدی این روش در تخمین ولتاژ و جریان سوئیچ‌ها می‌باشد به طوری که بیشینه خطای ولتاژ و جریان به کمتر از ۲ درصد محدود می‌شود.</p>

۱- مقدمه
 سایر سوئیچ‌ها مانند IGBT یا MOSFET می‌باشد [۱]. ارائه مدل مناسب و عملی برای تایریستور موجب ادراک بهتر عملکرد مبدل و طراحی دقیق‌تر فرآیند کنترلی می‌گردد و نیز نتایج شبیه‌سازی متکی بر آن مدل، به مقادیر واقعی نزدیک‌تر خواهد بود. روش‌های مدل‌سازی مرسوم مانند میانگین‌گیری فضای حالت^۲ (SSA) و یا مدل سوئیچ متوسط‌گیری شده^۳ (ASM)، قابل استفاده

امروزه استفاده از مبدل‌های تایریستوری در کاربردهای مانند شارژرها،^۱ HVDC، سیستم‌های محرکه، توان‌های بالا و غیره مرسوم است. استفاده از تایریستور از نظر هزینه مالی و قابلیت اطمینان دارای توجیه بهتری در مقایسه با

* پست الکترونیک نویسنده مسئول: a.skandarnezhad@yahoo.com

۱. دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

۲. استادیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

۳. دانشیار، دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

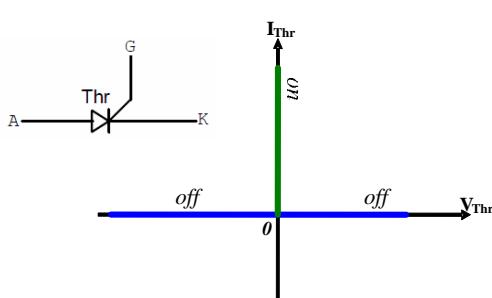
¹ High Voltage Direct Current

² State Space Averaging
³ Averaged Switch Model

منحنی، ۴۵ درجه دوران صورت می‌گیرد. در این مرحله می‌توان رابطه جریان برحسب ولتاژ را با یک بلوك کنترلی تک خروجی- تک خروجی^۳ (SISO) نمایش داد. آن‌گاه بلوك حاصله در مدار مبدل، جایگزین تایریستورها می‌شود. ارتباط سایر عناصر به این بلوك‌ها که همگی از نوع خطی هستند از طریق ماتریس‌های امپدانس Z و انتقال T برقرار می‌گردد. تعیین ماتریس‌های مذکور از طریق نظریه مداری مش و گره تحقق می‌یابد. سپس معادله مشخصه کلی سیستم به دست می‌آید که در یک سمت آن عمل‌گرهای تفاضلی و در سمت دیگر ترکیب خطی ولتاژ و جریان اجزای مدار موجود است. درایه ماتریس‌های این معادله گویای اثر هر کدام از پارامترهای مداری بر نقطه کار سوئیچ‌ها می‌باشد. در انتهای برای آن که کارآیی روش مطرح شده بررسی شود، یک مبدل تایریستوری نمونه را در نظر گرفته و با استفاده از نرم افزار MATLAB روش پیشنهادی اعمال گردید. از طرف دیگر مبدل نمونه با نرم افزار OrCAD/Pspice شبیه‌سازی شد و نتایج دو روش با هم مقایسه گردید که گویای کارآمدی روش مذکور می‌باشد. در انتهای بحث و نتیجه‌گیری مطالب ارائه شده، انجام می‌گیرد.

۲- تعیین بلوك کنترلی متناظر تایریستور

در شکل ۱ منحنی مشخصه $I-V$ ایده‌آل تایریستور آورده شده است.



شکل ۱- منحنی مشخصه جریان- ولتاژ تایریستور

^۳ Single Input Single Output

برای تایریستور نیست زیرا روش‌های مذکور بر مبنای معلوم بودن دوره کارکرد^۱ (D)، یعنی مشخص بودن زمان خاموشی کلید استوار هستند [۶-۲]. در حالی که در تایریستور زمان وصل کلید مشخص بوده ولی زمان خاموشی آن تابع شرایط مداری می‌باشد. همچنین به دلیل پائین بودن فرکانس کار تایریستور در مقایسه با سوئیچ‌های نیمه هادی دیگر، روش متوسط‌گیری چندان مناسب به نظر نمی‌رسد. گروه دیگری از مدل‌های ارائه شده برای تایریستور بر اساس ساختار فیزیک نیمه هادی درون آن بنا نهاده شده‌اند. مدل‌های به دست آمده از این روش دارای ساختار پیچیده و زمان بر بوده و دید سیستمی نمی‌دهند [۷-۱۰]. ولی مدل پیشنهادی در این مقاله، تایریستور را از منظر بیرونی مطالعه می‌کند. نرم افزارهای شبیه‌ساز کامپیوتری در این حوزه را می‌توان در دو دسته قرار داد. گروهی مانند Pspice از پارامترهای نیمه هادی درون قطعه استفاده کرده و رفتار آن را با ترکیب عناصر پایه الکتریکی آنالوگ مدل می‌کنند. گروه دیگر مانند MATLAB زمان شبیه‌سازی را به فواصل زمانی کوچک‌تری تقسیم کرده و با اعمال رفتار بیرونی سوئیچ از نظر باز یا بسته بودن به حل روابط ریاضی در هر بازه می‌پردازند و نتیجه محاسبات در هر بازه به عنوان مقادیر اولیه بازه بعدی محسوب می‌گردد. از این نظر این گروه دارای طبیعت نمونه‌گیر- نگهدار^۲ (S&H) و ناپیوسته هستند [۱۱-۱۳]. اجزای مبدل‌های تایریستوری از نظر رفتاری به دو نوع خطی و غیرخطی تقسیم‌بندی می‌شوند. در روش پیشنهادی، عناصر غیرخطی فقط شامل تایریستور و یا قطعاتی مثل دیود و تریاک بوده که با تعویض کردن آن‌ها با تایریستور با زاویه آتش معین، عملکرد مدار تغییر نمی‌نماید. عناصر خطی مدار نیز شامل مقاومت، سلف و خازن می‌باشد. در ادامه ابتدا منحنی مشخصه $V-I$ ایده‌آل تایریستور در نظر گرفته می‌شود، سپس در جهت خطی‌سازی و سهولت روابط ریاضی

^۱ Duty Cycle

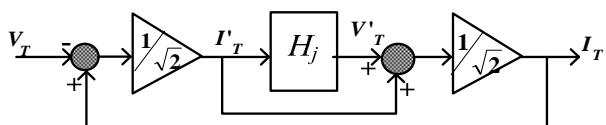
^۲ Sample and Hold

$$H_j(\omega t) = \frac{I'_T}{V'_T} = \begin{cases} -1 & \text{if } 0 \leq \omega t < \psi_j \\ +1 & \text{if } \psi_j \leq \omega t < \beta_j \\ -1 & \text{if } \beta_j \leq \omega t < 2\pi \end{cases} \quad (5)$$

جريان تایریستور قبل و بعد از دوران در رابطه ۶ بیان شده است.

$$\begin{cases} I_T = \frac{1}{\sqrt{2}}(V'_T + I'_T) \\ I'_T = \frac{1}{\sqrt{2}}(-V_T + I_T) \end{cases} \quad (6)$$

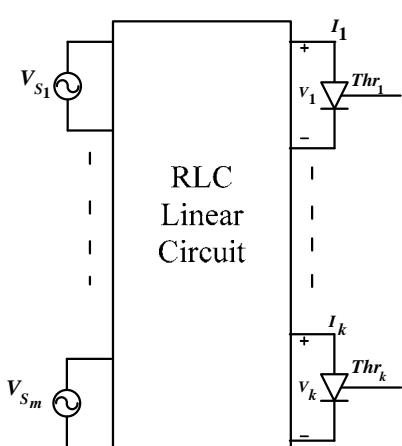
با توجه به رابطه ۶، بلوک کنترلی شکل ۴ استخراج می‌شود. ورودی بلوک، ولتاژ تایریستور بوده و خروجی جریان آن است. در ادامه بلوک، تایریستورهای موجود در بدنه مبدل باید با بلوک شکل ۴ تعویض شوند.



شکل ۴- بلوک کنترلی معادل تایریستور

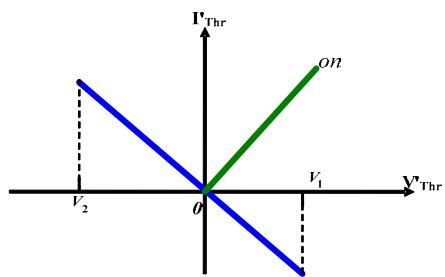
۳- جاگذاری بلوک کنترلی در ساختار مبدل

ساختار یک مبدل تایریستوری را در حالت کلی با شکل ۵ می‌توان نشان داد، که اجزای آن شامل سوئیچ‌ها، قطعات خطی و منابع ولتاژ اعم از DC و AC می‌شود.



شکل ۵- ساختار کلی مبدل تایریستوری

زمانی که تایریستور خاموش است نقطه کار روی محور افقی قرار دارد و وقتی روشن می‌شود روی محور عمودی قرار دارد. برای ایجاد سهولت در بیان ریاضی منحنی مشخصه، آن را ۴۵ درجه در جهت ساعت گرد دوران داده که در شکل ۲ نشان داده شده است.



شکل ۲- منحنی مشخصه دوران یافته تایریستور

محورهای مختصات دورانی در این وضعیت با نمادهای Γ و V نمایش داده می‌شود. ماتریس‌های دوران و معکوس آن به ترتیب در روابط ۱ تا ۴ مشخص شده است.

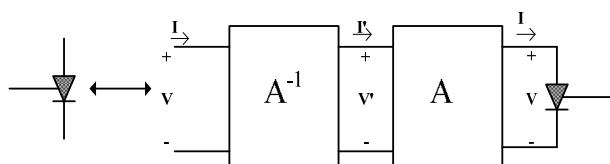
$$A = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \quad (1)$$

$$A^{-1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$\begin{bmatrix} V'_T \\ I'_T \end{bmatrix} = A \cdot \begin{bmatrix} V_T \\ I_T \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$\begin{bmatrix} V_T \\ I_T \end{bmatrix} = A^{-1} \cdot \begin{bmatrix} V'_T \\ I'_T \end{bmatrix} \quad (4)$$

لذا مقادیر ولتاژ و جریان به صورت شکل ۳ خواهد شد.



شکل ۳- ولتاژ و جریان پس از اعمال ماتریس دوران

تابع تبدیل جریان به ولتاژ مربوط به تایریستور \bar{I}_m در رابطه ۵ آورده شده است که ψ و β به ترتیب زوایای آتش و خاموشی آن هستند.

دانشمند آلمانی به همین نام ابداع شد. این روش در مسائل فیزیکی و مهندسی کارآمدی بالایی دارد. این الگوریتم دارای اقسام مختلفی است که متناسب با کاربرد مورد نیاز می‌توان یکی از آن‌ها را برگزید. یکی از نمایش‌های مرسوم آن، الگوریتم رانگ-کوتای مرتبه چهار می‌باشد که در رابطه ۹ تعریف شده است [۱۴ و ۱۵].

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x)$$

$$x(t_0) = x_0, \quad h = \Delta t$$

$$x_{n+1} = x_n + \frac{1}{6}(a + 2b + 2c + d)$$

$$a = f(t_n, x_n)$$

$$b = f\left(t_n + \frac{h}{2}, x_n + \frac{a}{2}\right)$$

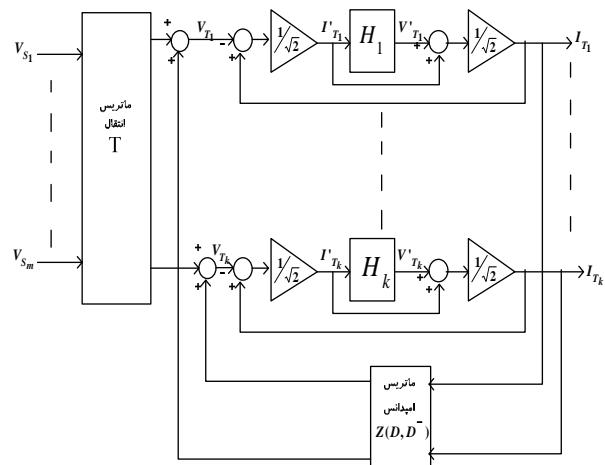
$$c = f\left(t_n + \frac{h}{2}, x_n + \frac{b}{2}\right)$$

$$d = f(t_n + h, x_n + c)$$

تعداد منابع ولتاژ برابر m و تایریستورها برابر k می‌باشد. همان‌گونه که در شکل ۴ ملاحظه می‌شود پارامتر ورودی بلوك کنترلی، ولتاژ V_T است. اثر منابع ولتاژ بر تریستورها را با ماتریس انتقال T و اثر اجزای خطی مدار با ماتریس امپدانس Z بیان می‌شود. با توجه به وجود سلف و خازن در مدار، ماتریس Z شامل عمل‌گر تفاضلی خواهد بود که در رابطه (۷) تعریف شده است.

$$D = \frac{d}{dt}, \quad D^- = \int dt \quad (7)$$

با جایگزین کردن بلوك شکل ۴ به جای تریستورها در شکل ۵، ساختار نهایی شکل ۶ حاصل می‌شود.



شکل ۶- ساختار نهایی مدل پس از جایگزینی بلوك کنترلی با توجه به ساختار شکل ۶، می‌توان معادله مشخصه کلی مدل را تعیین کرد که در رابطه ۸ تعریف شده است.

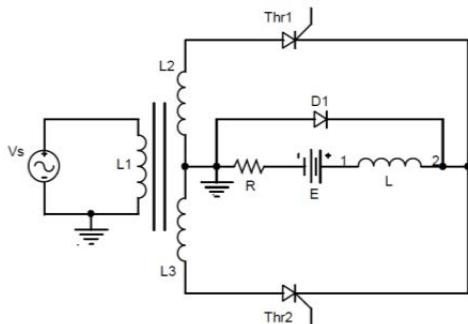
$$\begin{bmatrix} V_{T_1} \\ \vdots \\ V_{T_k} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} T & & \\ & \ddots & \\ & & T \end{bmatrix}_{k \times m} \begin{bmatrix} V_{S_1} \\ \vdots \\ V_{S_m} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} Z(D, D^-) & & \\ & \ddots & \\ & & Z(D, D^-) \end{bmatrix}_{k \times k} \begin{bmatrix} I_{T_1} \\ \vdots \\ I_{T_k} \end{bmatrix} \quad (8)$$

حال برای حل رابطه ۸ که شامل عمل‌گر تفاضلی و انتگرالی است، از روش رانگ-کوتای چند متغیره استفاده می‌شود.

۴- روش رانگ-کوتای چند متغیره

الگوریتم رانگ-کوتا یکی از روش‌های محاسبات عددی در حل معادلات تفاضلی می‌باشد که اولین بار توسط دو

^۱ Multivariable Fourth-Order Runge-Kutta Algorithm



شکل ۷- مبدل نمونه

مقادیر قطعات مدار در جدول ۱ مشخص شده است.

جدول ۱- مقادیر اجزای مدار مبدل

$V_s = 220V, 50Hz$
$N_2/N_1 = 2/3, N_3/N_1 = 1/2$
$R = 20\Omega, E = 80, L = 0.2H$
$\Psi_{Th1} = 70^\circ, \Psi_{Th2} = 270^\circ$

مدار نمونه شکل ۸ با نرم افزار Pspice شبیه‌سازی می‌شود. زوایه آتش تایریستورها با تنظیم منابع پالس متصل به پایه گیت آن‌ها تعیین می‌شوند. به جای دیود هرزگرد D_1 ، تایریستور Thr_d با مقاومتی بین پایه آند و گیت قرار داده شده است تا مدار یکدست شود.

ترانس مدار ایده‌آل بوده و ضریب تزویج آن واحد می‌باشد. لذا مقدار اندوکتانس سلف‌ها متناسب با مربع تعداد دور سیم پیچ‌ها خواهد بود که در رابطه ۱۵ بیان شده است.

$$\frac{L_2}{L_1} = \left(\frac{N_2}{N_1}\right)^2$$

$$\frac{L_3}{L_1} = \left(\frac{N_3}{N_1}\right)^2 \quad (15)$$

چون در کتابخانه Pspice ترانس سر وسطدار موجود نمی‌باشد از قطعه K_Linear برای ایجاد تزویج بین سه سلف L_1, L_2, L_3 استفاده می‌شود. در صورتی که معادله مشخصه رابطه ۸ در مورد این مبدل تحقق یابد به صورت رابطه ۱۶ زیر ظاهر می‌شود.

$$\begin{bmatrix} V_{T_1} \\ V_{T_2} \\ V_{T_D} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{n_2}{n_1} & -1 \\ \frac{-n_3}{n_1} & -1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_{S_1} \\ E \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -R - LD & -R - LD & -R - LD \\ -R - LD & -R - LD & -R - LD \\ -R - LD & -R - LD & -R - LD \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{T_1} \\ I_{T_2} \\ I_{T_D} \end{bmatrix} \quad (16)$$

برای سهولت نمایش می‌توان رابطه ۱۰ را در قالب روابط ۱۱ و ۱۲ نمایش داد.

$$X = (x_1, x_2, \dots, x_k) \quad (11)$$

$$F = (f_1, f_2, \dots, f_k) \quad (11)$$

$$\frac{dX}{dt} = F(X) \quad (12)$$

$$X(t_0) = X_0$$

مانند حالت یک متغیره می‌توان به محاسبه پارامترهای a, b, c و d پرداخت که در رابطه ۱۳ نشان داده شده است.

$$a_n = F(X_n)$$

$$b_n = F(X_n + \frac{a_n}{2}) \quad (13)$$

$$c_n = F(X_n + \frac{b_n}{2})$$

$$d_n = F(X_n + c_n)$$

$$X_{n+1} = X_n + \frac{1}{6}(a_n + 2b_n + 2c_n + d_n)$$

متغیرهای رابطه ۱۳ برداری هستند؛ برای تعیین یکی از متغیرها مثل x_j مانند رابطه ۱۴ عمل می‌شود.

$$a_{j,n} = f_j(x_{1,n}, \dots, x_{k,n})$$

$$b_{j,n} = f_j(x_{1,n} + \frac{a_{1,n}}{2}, \dots, x_{k,n} + \frac{a_{k,n}}{2})$$

$$c_{j,n} = f_j(x_{1,n} + \frac{b_{1,n}}{2}, \dots, x_{k,n} + \frac{b_{k,n}}{2}) \quad (14)$$

$$d_{j,n} = f_j(x_{1,n} + c_{1,n}, \dots, x_{k,n} + c_{k,n})$$

$$x_{j,n+1} = x_{j,n} + \frac{1}{6}(a_{j,n} + 2b_{j,n} + 2c_{j,n} + d_{j,n})$$

۵- ارائه یک مبدل نمونه و مقایسه نتایج

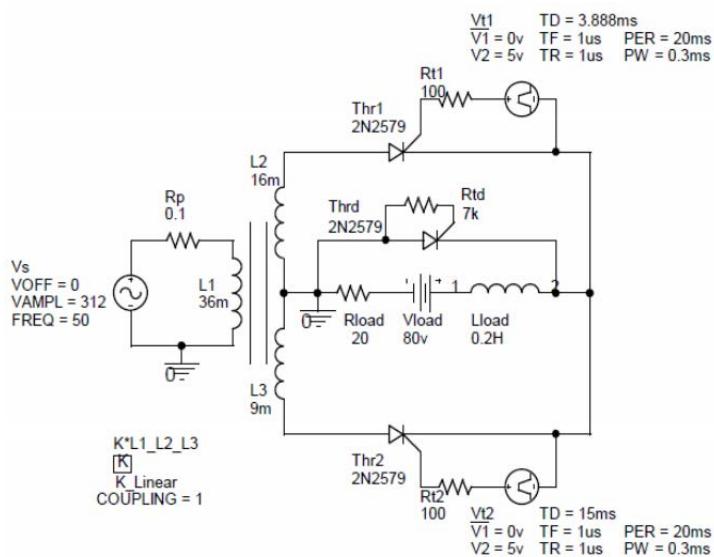
در ادامه برای آن‌که دقیق و کارآیی روش پیشنهادی کنترل شود، نتایج شبیه‌سازی و تحلیلی روی مبدل شکل ۷ اجرا و مقایسه می‌گردد.

می‌دهد نتایج روش پیشنهادی با نتایج شبیه‌سازی با دقت بالایی با یکدیگر مطابقت دارند.

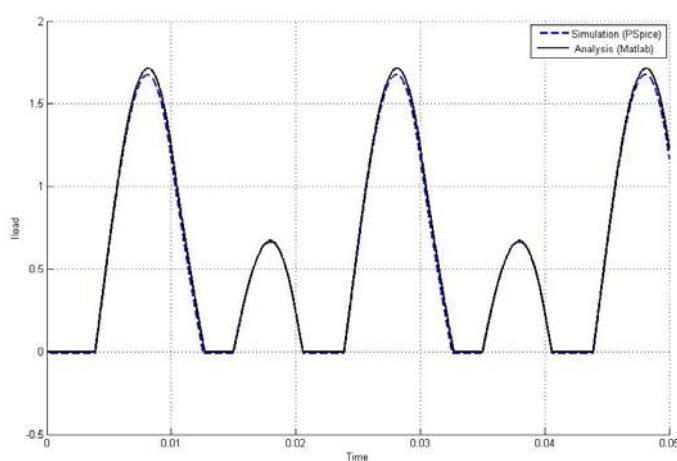
در شکل ۹ جریان بار خروجی مبدل (شاخه L-E-R) به دو روش شبیه‌سازی و آنالیز ملاحظه می‌شود. در این شکل نیمسیکل‌های با دامنه بزرگتر ناشی از القاء روی سیم پیچ L_2 با تعداد دور بیشتر و نیمسیکل‌های با دامنه کوچکتر ناشی از القاء روی سیم پیچ L_1 با تعداد دور کمتر هستند. همچنین اندک اختلاف ولتاژ موجود بین منحنی تئوری و منحنی شبیه‌سازی به خاطر ایده‌آل در نظر گرفتن رفتار تریستور در حالت تئوری است.

معادله مشخصه ۱۶ را به روش رانگ-کوتا همان‌گونه که در بخش قبل شرح داده شد در محیط MATLAB حل کرده و نتیجه تحلیل با نتیجه شبیه‌سازی مقایسه می‌گردد. پاسخ تحلیل شامل مجہولات معادله تفاضلی رانگ-کوتا یعنی ولتاژ و جریان سوئیچ‌ها می‌باشد. با تعیین معکوس ماتریس معادله مشخصه مبدل می‌توان نقطه کار عناصر غیرفعال مدار را نیز محاسبه کرد.

در ادامه، شکل موج سیگنال‌های مختلف مدار از دو روش: شبیه‌سازی با نرم افزار Pspice و تحلیل عددی با نرم افزار MATLAB با هم مقایسه شده‌اند. این مقایسه نشان



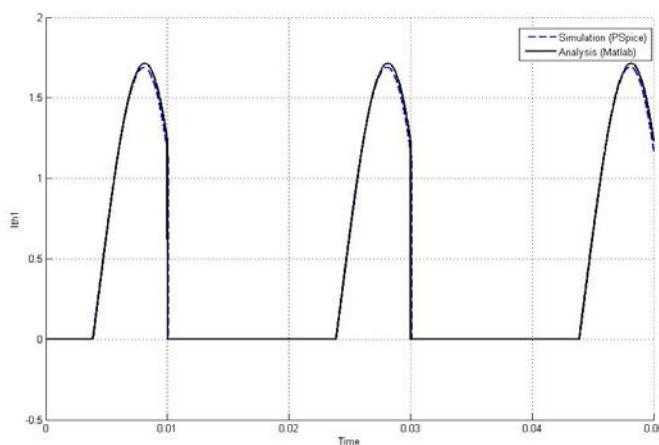
شکل ۸- مدار شبیه‌سازی شده در محیط Pspice



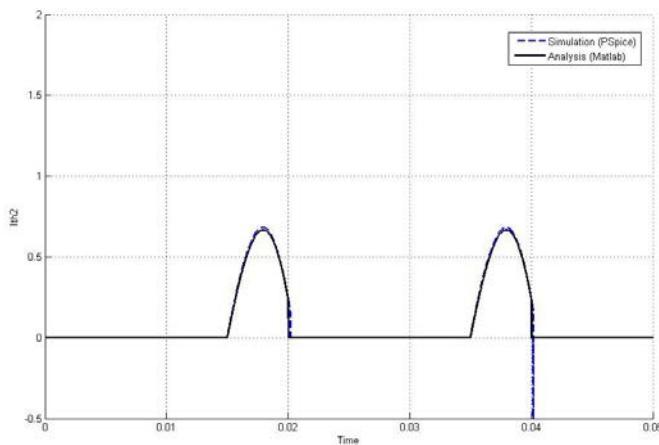
شکل ۹- جریان بار به دست آمده از دو روش

در شکل ۱۱ جریان تایریستور Thr2 حاصل از دو روش ملاحظه می‌شود. همان‌طور که در شکل ۹ مشاهده می‌شود جریان بار از زمان ۱۵ms تا ۲۱ms تداوم می‌یابد. این مدت زمان شامل دو بخش می‌شود؛ در بخش اول از زمان ۱۵ms تا ۲۰ms جریان بار از تریستور Thr2 گذشته که در شکل ۱۱ مشاهده می‌شود. بخش دوم از زمان ۲۰ms تا ۲۱ms جریان در دیود هرزگرد Thrd می‌شود.

در شکل ۱۰ جریان تایریستور Thr1 حاصل از دو روش ملاحظه می‌شود. همان‌طور که در شکل قبل مشاهده شد جریان بار از زمان ۳.۸ms تا ۱۲.۶ms تداوم می‌یابد. این مدت زمان شامل دو بخش می‌شود؛ در بخش اول از زمان ۳.۸ms تا ۱۰ms جریان بار از تریستور Thr1 گذشته که در شکل ۱۰ مشخص می‌باشد و در بخش دوم از زمان ۱۰ms تا ۱۲.۶ms در دیود هرزگرد Thrd جاری می‌شود.



شکل ۱۰- جریان تایریستور Thr1 حاصل از دو روش



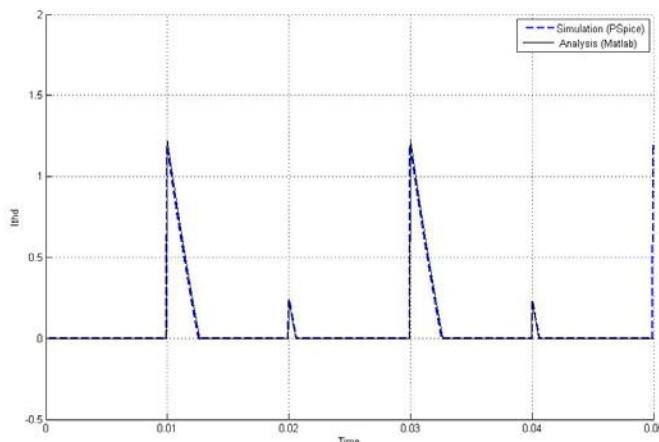
شکل ۱۱- جریان تایریستور Thr2 حاصل از دو روش

باید جریان هرزگردی به صفر برسد. این موضوع یک حداقلی را برای زاویه آتش ایجاد می‌کند. در شکل ۱۳ ولتاژ تایریستور Thr1 حاصل از دو روش ملاحظه می‌شود. این کمیت در انتخاب ولتاژ شکست تریستور Thr1 می‌تواند مفید باشد. همان‌طور که در این

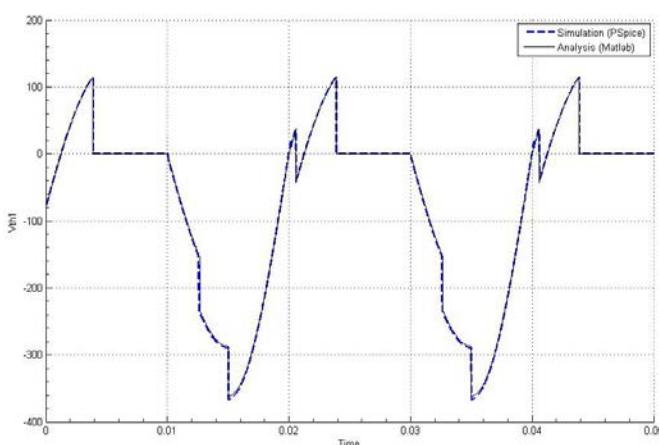
در شکل ۱۲ جریان دیود هرزگرد Thrd حاصل از دو روش ملاحظه می‌شود. با توجه به شکل، در بازه‌های زمانی که تریستور ۱ و ۲ خاموش می‌شوند که معادل با زوایای ۱۸۰ و ۳۶۰ درجه هستند، جریان بار از دیود هرزگرد Thrd عبور می‌کند. قبل از آتش‌شدن تریستور بعدی

مدل سازی و تحلیل عددی مبدل های تایریستوری به روش رانگ-کوتای چند متغیره
تریستور2 Thr2 می تواند مفید باشد. همان طور که در این
شکل مشاهده می شود بیشترین ولتاژ معکوس در زاویه
۹۰ درجه و در حدود ۴۰۰ ولت است.

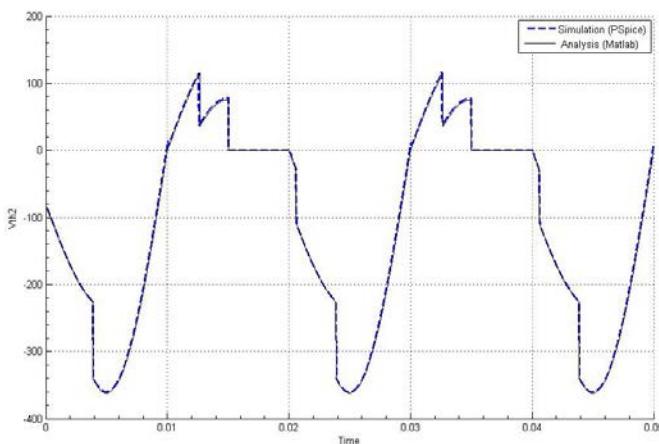
شکل مشاهده می شود بیشترین ولتاژ معکوس در زاویه
۲۷۰ درجه و در حدود ۴۰۰ ولت است.
در شکل ۱۴ ولتاژ تایریستور2 Thr2 حاصل از دو روش
ملاحظه می شود. این کمیت در انتخاب ولتاژ شکست



شکل ۱۲- جریان دیود Thr2 حاصل از دو روش



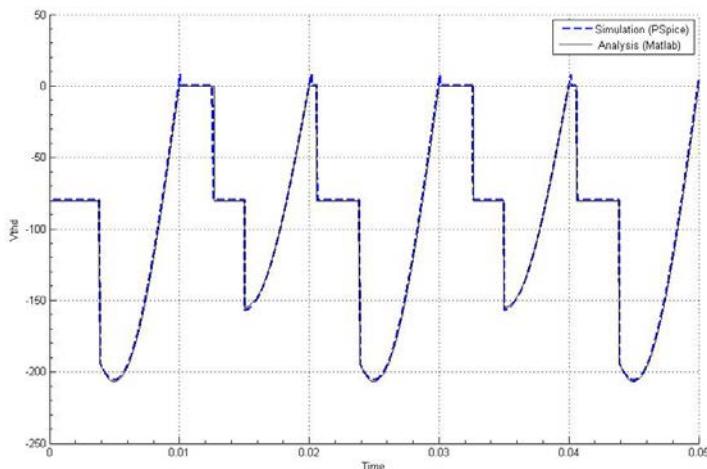
شکل ۱۳- ولتاژ تایریستور1 Thr1 حاصل از دو روش



شکل ۱۴- ولتاژ تایریستور2 Thr2 حاصل از دو روش

هستند. لذا در این کاربرد، دیودی با ولتاژ 300V ولت جهت اطمینان از عدم شکست آن کفایت می‌کند. با محاسبه جریان موثر عبوری از تریستورها می‌توان سطح توانی مورد نیاز را با دقت بالا تخمین زد.

در شکل ۱۵ ولتاژ دیود Thrd حاصل از دو روش ملاحظه می‌شود. این کمیت در انتخاب ولتاژ شکست دیود هرزگرد Thrd می‌تواند مفید باشد. همان‌طور که در این شکل مشاهده می‌شود بیشترین ولتاژهای معکوس در زوایای 90° و 270° درجه و به ترتیب در حدود 200 و 150 ولت



شکل ۱۵- ولتاژ دیود Thrd حاصل از دو روش

در انتهای این معادله تفاضلی به روش رونگ-کوتای چندمتغیره که یکی از الگوریتم‌های پرکاربرد محاسبات عددی است، حل می‌گردد. مقایسه نتایج به دست آمده از این روش با نتایج شبیه‌سازی گویای کارآمدی روش مطرح شده است. البته این روش دارای محدودیت‌هایی است که می‌توان آن را برای کارهای آتی در این زمینه پیشنهاد داد، از جمله این‌که منحنی مشخصه تایریستور ایده‌آل درنظر گرفته شد. در حالی که اگر غیرایده‌آل درنظر گرفته شود نتایج حاصله دقت بیشتری خواهد داشت. این امر موجب پیچیدگی مدل و افزایش زمان حل معادلات خواهد شد. همچنین این روش را نمی‌توان برای مبدل‌های شامل یک تریستور به مدار موجب می‌شود ماتریس تفاضلی Z هم از سطر و از ستون یک واحد افزایش یابد لذا تعداد عمل‌گرهای تفاضلی اضافه شده به معادله مشخصه برابر $2k+1$ خواهد شد که در آن k تعداد تریستورها قبل از اضافه شدن سوئیچ جدید می‌باشد.

مقایسه نمودارهای به دست آمده در شکل‌های ۹ تا ۱۵، نشان می‌دهد که تطابق خوبی بین روش پیشنهادی با نتایج شبیه‌سازی وجود دارد، به طوری که بیشینه خطای کمتر از 2 درصد محدود می‌شود. مقدار لحظه‌ای خطای مطابق با رابطه 17 محاسبه می‌شود.

$$\text{err}(t) = \frac{i_p(t) - i_m(t)}{i_p(t)} \times 100\% \quad (17)$$

در رابطه فوق مقادیر $i_p(t)$ و $i_m(t)$ به ترتیب جریان‌های تعیین شده با نرم افزار MATLAB و Pspice است.

۶- نتیجه گیری

در این مقاله ابتدا یک مدل کنترلی برای تایریستور ارائه شد که از منحنی مشخصه دوران یافته آن نشات می‌گیرد. سپس بلوک کنترلی در ساختار مبدل جایگزین می‌شود. آنگاه معادله مشخصه ماتریسی کل مبدل به دست می‌آید،

مراجع

- [1] Riyaz, A., Iqbal, A., Moinoddin, S., MoinAhmed, S.K., Abu-Rub, H. (2009). "Comparative performance analysis of Thyristor and IGBT based induction motor soft starters". International Journal of Engineering, Science and Technology, Vol. 1, No. 1, pp. 90-105.
- [2] Davoudi, A., Jatskevich, J., Chapman P.L. (2007). "State-space average-value modelling of capacitor-based switching stages: including conduction losses". Electronics Letters, Vol. 43, No. 16, pp. 893-895.
- [3] Davoudi, A., Jatskevich, J., Rybel, T.D. (2006). "Numerical state space average value modeling of PWM DC-DC converters operating in DCM and CCM". IEEE Trans. on Power Electronics, Vol. 21, No. 4, pp. 1003-1012.
- [4] Ivan, C.M., Lascu, D., Popescu, V. (2007). "An averaged switch model including conduction losses for boundary conduction mode DC-DC converters". Proceedings of the IMCAS'07, 6th International Conference on Instrumentation and Circuit, Wisconsin, USA, pp. 164-169.
- [5] Kazmierczuk, M.K. (2008). "Pulse-width modulated DC-DC power converters". 1st Edition, John Wiley, New York.
- [6] Basso, C.P. (2008). "Switch mode power supplies: spice simulation and practical designs". 1st Edition, McGraw-Hill, New York.
- [7] Song, Z., Hugo, Y., Pang, Y. (2011). "The research on transient analysis and auxiliary circuit of power thruster". Proceedings of the 4th International Conference on Electric Utility, DRPT, Shandong, China, pp. 1667-1670.
- [8] Bernardes, J., Dahlgren, D. (2005). "Modeling and analysis of thruster and diode reverse recovery in railgun pulsed power circuits". Proceedings of the Conference on Pulsed Power, Monterey, USA, pp. 79-82.
- [9] Tiab, S.B., Hulley, L.N., Wu, Z., Shepherd, W. (1992) "Thruster switch model for power electronic circuit simulation in modified SPICE 2". IEEE Trans. on Power Electronic, Vol. 7, No. 3, pp. 568-580.
- [10] Sayah, G.T., Zekry, A.H.A., Ragaie H.F., Soliman, F.A. (2003). "A spice model of a thruster with high injection effects and conductivity modulation". Proceedings of the 15th International Conference on Microelectronics (ICM), Cairo, Egypt, pp. 344-347.
- [11] Raghuwanshi, S.S., Singh, A., Mokhariwale, Y. (2012). "A comparison and performance of simulation tools MATLAB/ SIMULINK, PSIM and PSPICE for power electronic circuits". IJARCSSE, Vol. 2, No. 3, pp. 187-191.
- [12] Alexander, S.A., Manigandan, T., Kumar, M.D., Vardhan, R.V. (2012). "A comparison of simulation tools for power electronics". Proceedings of International Simulation Conference, ISCI 2012, India, Bombay.
- [13] Pattanayak, S.B. (2009). "Power electronics: computer simulation and analysis". Bach. Thesis, Rourkela University.
- [14] Leveque, R.J. (2005). "Finite difference methods for differential equations". DRAFT VERSION for use in the course AMath 585-586, University of Washington, pp. 100-106.
- [15] Heinbockel, J.H., (2006). "Numerical methods for scientific computing". Trafford Publishing, Canada, pp. 303-330.